

研究評価委員会「高輝度・高効率次世代レーザー技術開発」
(中間評価) 分科会

日時：平成30年6月8日(金) 9:45～17:25
場所：TKP 赤坂駅カンファレンスセンター ホール14C

議事次第

(公開セッション)

- | | | |
|------------------------------|-------------|-------|
| 1. 開会、資料の確認 | 9:45～ 9:49 | (4分) |
| 2. 分科会の設置について | 9:49～ 9:53 | (4分) |
| 3. 分科会の公開について | 9:53～ 9:57 | (4分) |
| 4. 評価の実施方法について | 9:57～10:05 | (8分) |
| 5. プロジェクトの概要説明 | | |
| 5.1 事業位置付け・必要性、研究開発マネジメント | 10:05～10:25 | (20分) |
| 5.2 研究開発成果、成果の実用化に向けた取組及び見通し | 10:25～10:55 | (30分) |
| 5.3 質疑応答 | 10:55～11:25 | (30分) |
| 休憩 | 11:25～11:35 | (10分) |

【非公開セッション】

- | | | |
|---|-------------|-------|
| 6. プロジェクトの詳細説明 | | |
| 6.1 【項目④】次世代レーザー及び加工の共通基盤技術開発
[説明 30分、質疑応答 20分] | 11:35～12:25 | (50分) |
| 休憩(昼食) | 12:25～13:15 | (50分) |
| 6.2 【項目①】高品位レーザー加工技術の開発
[説明 20分、質疑応答 15分、入替 2分] | 13:15～13:52 | (37分) |
| 6.3 【項目②】高出力レーザーによる加工技術の開発
[説明 20分、質疑応答 15分、入替 2分] | 13:52～14:29 | (37分) |
| 6.4 【項目③-1】フォトリック結晶レーザーの短パルス化・短波長化
[説明 10分、質疑応答 8分、入替 2分] | 14:29～14:49 | (20分) |
| 6.5 【項目③-2】高品質AlN結晶基板を用いた最短波長領域高出力深紫外LDの研究開発
[説明 10分、質疑応答 8分] | 14:49～15:07 | (18分) |
| 休憩 | 15:07～15:20 | (13分) |
| 6.6 【項目③-3】高効率加工用GaN系高出力・高ビーム品質半導体レーザーの開発
[説明 10分、質疑応答 8分、入替 2分] | 15:20～15:40 | (20分) |

- 6.7 【項目③-4】高出力・高ビーム品質動作を可能とする新型面発光レーザーの研究開発
[説明 10 分、質疑応答 8 分、入替 2 分] 15:40～16:00 (20 分)
- 6.8 【項目③-5】高効率・高出力量子ドットレーザーの研究開発
[説明 10 分、質疑応答 8 分、入替 2 分] 16:00～16:20 (20 分)
- 6.9 【項目③-6】革新的小型・高効率UVレーザー光源の開発
[説明 10 分、質疑応答 8 分、入替 2 分] 16:20～16:40 (20 分)
7. 全体を通しての質疑 16:40～16:55 (15 分)
[一般傍聴者入室・休憩 5 分]
- 【公開セッション】
8. まとめ・講評 17:00～17:20 (20 分)
9. 今後の予定 17:20～17:25 (5 分)
10. 閉会